

2SA1006,1006A,1006B/2SC2336,2336A,2336B

PNP/NPNエピタキシャル形
シリコントランジスタ(EBT)

低周波電力増幅, 高周波電力増幅用

PNP/NPN Silicon Epitaxial Transistor(EBT)
Audio Frequency Power Amplifier
High Frequency Power Amplifier

○実効出力150~500 W高級ステレオパワーアンプのドライバ段として最適。

○高耐圧である。→ $V_{CEO}=180\text{ V}, 200\text{ V}, 250\text{ V}$

○安全動作領域が広い。

○ f_T が高い。→80/95 MHz TYP.

○ h_{FE} リニアリティが良く, コンプリメンタリ性も良い。

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

項目	略号	2SA1006	2SA1006A	2SA1006B	2SC2336	2SC2336A	2SC2336B	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-180	-200	-250	180	200	250	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-180	-200	-250	180	200	250	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}		-5.0			5.0		V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$		-1.5			1.5		A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *		-3.0			3.0		A
全損失	$P_{T(T_a=25\text{ }^\circ\text{C})}$		1.5			1.5		W
全損失	$P_{T(T_c=25\text{ }^\circ\text{C})}$		25			25		W
ジャンクション温度	T_j		150			150		$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}		-55~+150			-55~+150		$^\circ\text{C}$

* $PW \leq 10\text{ ms}$, duty cycle $\leq 50\%$

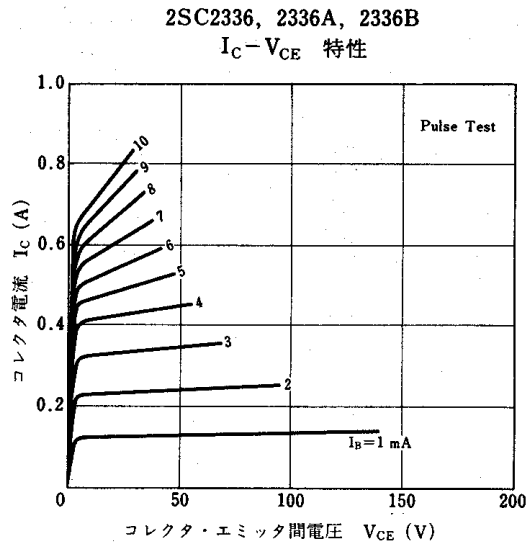
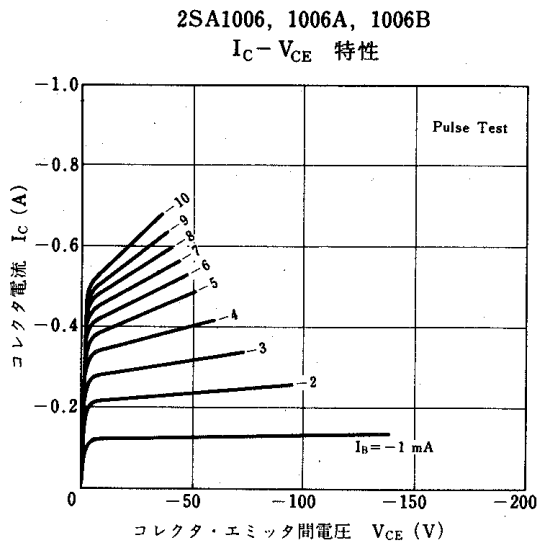
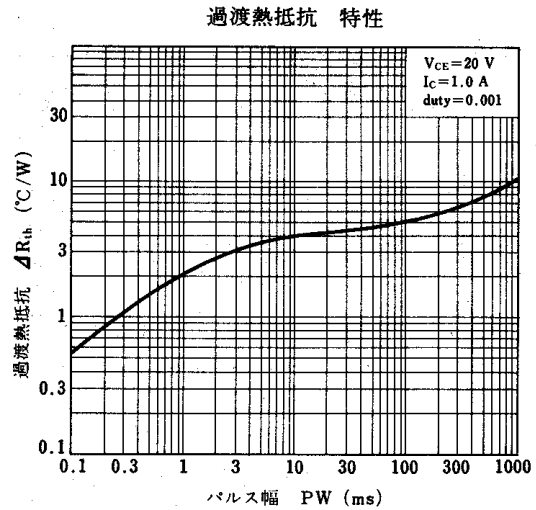
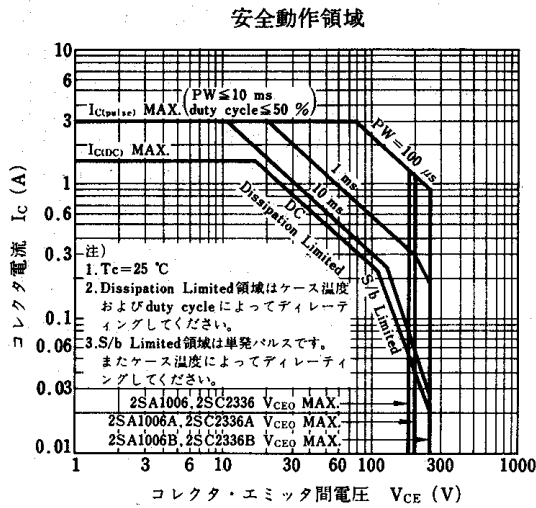
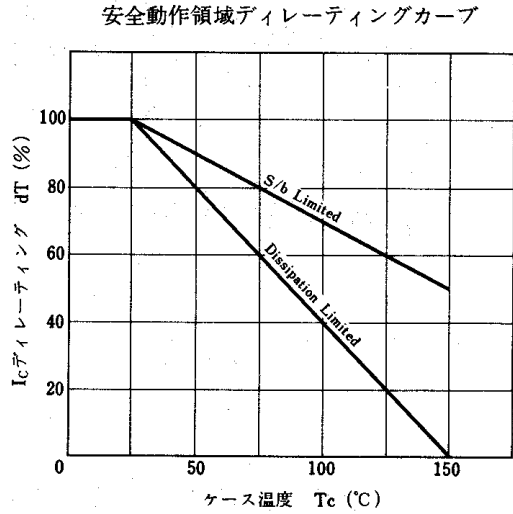
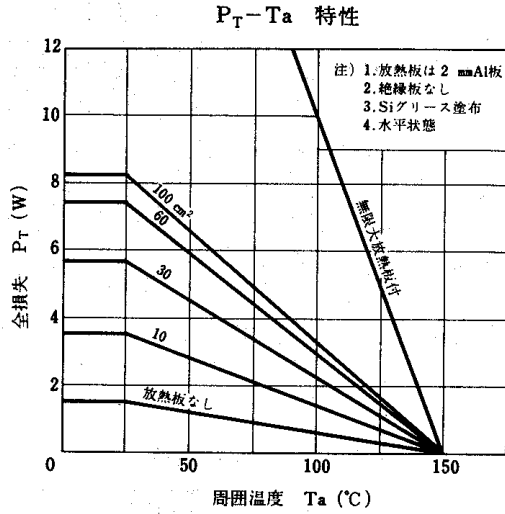
電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$) 2SA1006,1006A,1006B/2SC2336,2336A,2336B

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-150/150\text{ V}, I_E=0$			-1.0/1.0	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-3.0/3.0\text{ V}, I_C=0$			-1.0/1.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=-5.0/5.0\text{ V}, I_C=-5.0/5.0\text{ mA}$ *	30	120/90		
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE}=-5.0/5.0\text{ V}, I_C=-150/150\text{ mA}$ *	60	120	320	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500/500\text{ mA}, I_B=-50/50\text{ mA}$ *		-0.4/0.3	-1.0/1.0	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-500/500\text{ mA}, I_B=-50/50\text{ mA}$ *		-1.0/1.0	-1.5/1.5	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=-10/10\text{ V}, I_C=-100/100\text{ mA}$		80/95		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10/10\text{ V}, I_E=0, f=1.0\text{ MHz}$		45/30		pF

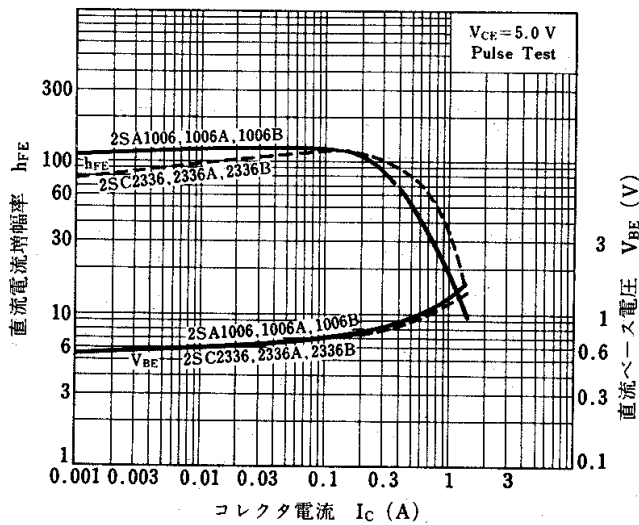
* Pulse Test / $PW \leq 350\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$

h_{FE2} 区分 / R: 60~120 Q: 100~200 P: 160~320

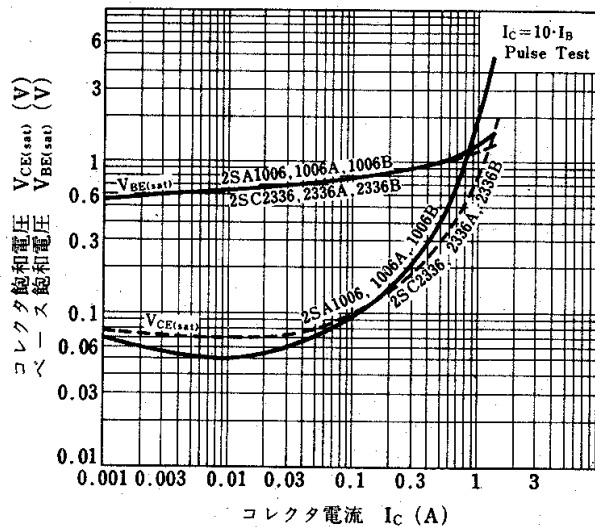
特性曲線 / TYPICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)



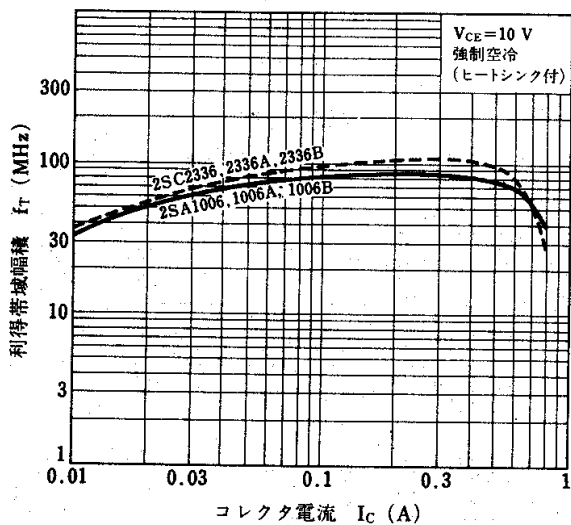
h_{FE} , $V_{BE}-I_C$ 特性



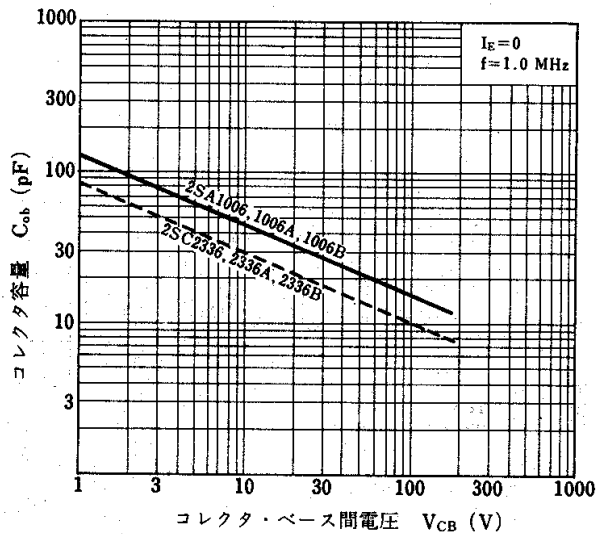
$V_{CE(sat)}$, $V_{BE(sat)}-I_C$ 特性



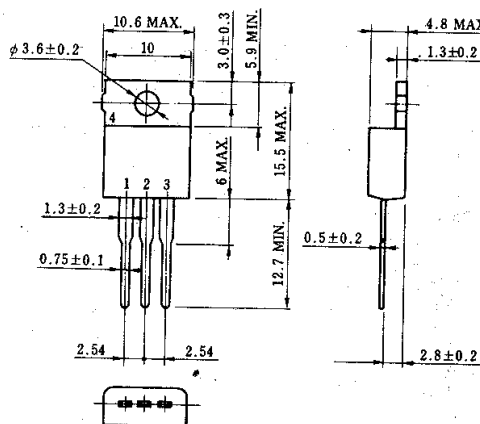
f_T-I_C 特性



$C_{ob}-V_{CB}$ 特性



外形図/PACKAGE DIMENSIONS (Unit : mm)



電極接続

1. Base
2. Collector(Fin)
3. Emitter
4. Fin

Transistors

• Darlington Power Transistors

V _{CEO} [V]	I _c (DC) [A] Package	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10	15	25
		60	TO-126		NTD985 NTB794				
80	TO-126		NTD986 NTB795				NTD411 (TO-3)		
100	TO-220AB				NTD560 NTB601		NTD1210 (MP-80) NTB897 (MP-80)	2SD1296 (MP-80) NTD412 (TO-3)	2SD1297 (MP-80)
400	TO-220AB				NTD987 NTD1162 (300V)		NTD565 (TO-3) 2SD1298 (MP-80)		

• Power Transistors

V _{CEO} [V]	I _c (DC) [A] Package	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10	15
		30~45	TO-126			2SB772 2SD882 2SB744 2SD794		
TO-220AB							NTA1129 NTC2654	
60	TO-126			2SB744A 2SD794A				
	TO-220AB				NTA1069 NTC2516	NTB707 NTD568	NTD1070 (MP-80)	
80	TO-220AB			2SB703 2SD743	NTA1069A NTC2516A	NTB708 NTD569		
100~150	TO-220AB		NTA1008 NTC2331		NTC2517	NTA1010 NTC2334		
	MP-80							NTC2750
	TO-220AB	2SA1006 2SC2336						
400	TO-220AB		NTC2333			NTC2335		
	MP-80						NTC2749	NTC2751

• Small-Signal Transistors

V _{CEO} [V]	I _c (DC) [mA] Package	100	200	300	500	700~1000
		25	TO-92			
30				*2SC1280A		
40	TO-92					2SC2720, 2SA1153
	TO-18		2SC943, 2SA603			
50	TO-92	2SC945, 2SA733 2SC2718, 2SA1151				
	SP-8					2SD571, 2SB605
60	TO-92			2SC2003, 2SA954		
	SP-8					2SC2721, 2SA1154
80	TO-92			2SC2719, 2SA1152		
	SP-8					2SD1312, 2SB984

*Darlington

• Mini-Mold Transistors for Hybrid ICs

Type No.	I _c [mA]	V _{CEO} [V]	P _d [mW]
2SA811A	-50	-120	200
2SA812	-100	-50	150
2SB624	-700	-25	200
2SB736	-300	-60	200
2SC1622A	50	120	200
2SC1623	100	50	150
2SC1654	50	160	150
2SD596	700	25	200
2SD780	300	60	200

• Power Mini-Mold Transistors for Hybrid ICs

NPN No.	V _{CEO} [V]	I _c [A]	P _T [W]	h _{FE} [—]	PNP No.
2SD1000	50	0.7	2.0	90~400	2SB799
2SD1006	100	0.7	2.0	90~400	2SB805
2SD1007	120	0.7	2.0	90~400	2SB806
2SD999	25	1.0	2.0	90~400	2SB798
2SD1005	80	1.0	2.0	90~400	2SB804
2SD1001	50	0.3	2.0	90~400	2SB800